	dul 2-5	52: NANOT	TECHNOLOGIE .				ETI	T-410	
Tui	Turnus		Dauer	Studienabschnitt	LP	Präsenzanteil	Eigens	Eigenstudium	
Jäh	ährlich zum SoSe 1 Semester			2. Semester	10	70 h 230 h			
1	Modulstruktur								
	Nr.	Element / Lehrveranstaltung			LSF-Nr.	Тур	sws		
	1	Nanotechnologie Vorlesung				080190	V	2	
	2	Nanotec	hnologie Übung			080191 A	Ü	2	
	3	Nanotec	hnologie Praktik	um		080191 B	Р	2	
2		Lehrveranstaltungssprache Deutsch							
	•	 Grundlagen höchstskalierter elektronischer Bauelemente, Energie- und Leistungsverbrauch Herstellungsprozesse der Mikro- und Nanotechnologie Halbleiter, Verbindungshalbleiter, Oxidelektronik und amorphe Halbleiter Niederdimensionale Materialien (Quantenpunkte, Nanodrähte, 2D-Materialien) Konzepte neuartiger mikro- und nanoelektronischer Bauelemente Nanoionische Systeme Einführung in die Photonik und Spintronik Literatur R. Waser, Nanoelectronics and Information Technology, 3. Auflage, Wiley-VCH, 2012 H. Klar, T. Noll, Integrierte Digitale Schaltungen, 3. Auflage, 2015, Springer							
						•			
4	Komp Nach von S niede Anwe Lage,	petenzen erfolgreick kalierungs erdimensio	Integrierte Digit hem Abschluss of und Integrationale Materialier undlegender Her		Studierender Mikro- un chfrequenza	Springer en Konzepte und Stra d Nanoelektronik. Da anwendungen sowie o chnologie. Die Studier	zu zählen die praktis renden sir	neuartige sche nd in der	
5	Komp Nach von S niede Anwe Lage, zu ve Prüfu Modu Studi	er, T. Noll, erfolgreick kalierungs erdimensio endung gru die Konze rgleichen. ulprüfung: enleistung	hem Abschluss of the control of the	ale Schaltungen, 3. Auf des Moduls kennen die nsproblemen moderne n und Halbleiter für Ho estellungsmethoden in	Studierender Mikro- un chfrequenza der Nanoteceit moderne	en Konzepte und Stra d Nanoelektronik. Da anwendungen sowie o chnologie. Die Studier er Mikro- und Nanote der Klausur (max. che in Element 3.	zu zählen die praktis renden sir chnologie 180 M	neuartige sche nd in der	
	Komp Nach von S niede Anwe Lage, zu ve Prüfu Modu Studi *Die	er, T. Noll, erfolgreich kalierungs erdimensio endung gru die Konze rgleichen. ulprüfung: enleistung genauen P	hem Abschluss of the Materialies and Integration and Materialies and Integration and Integrati	des Moduls kennen die nsproblemen modernen und Halbleiter für Horstellungsmethoden in auf die Leistungsfähigk Prüfung (max. 40 N. Bearbeitung der Praktäten werden spätesten	Studierender Mikro- un chfrequenza der Nanoteceit moderne	en Konzepte und Strad Nanoelektronik. Da anwendungen sowie ochnologie. Die Studier Mikro- und Nanote der Klausur (max. She in Element 3. anstaltung bekannt ge	zu zählen die praktis renden sir chnologie 180 M	neuartige sche nd in der qualitativ	
	Komp Nach von S niede Anwe Lage, zu ve Prüfu Modu *Die Prüfu X	er, T. Noll, erfolgreich kalierungs erdimensio endung gru die Konze rgleichen. ulprüfung: enleistung genauen P ungsforme Modulpr	hem Abschluss of the Materialies and Integration and Materialies and Integration and Integrati	des Moduls kennen die nsproblemen modernen und Halbleiter für Horstellungsmethoden in auf die Leistungsfähigk Prüfung (max. 40 N. Bearbeitung der Praktäten werden spätesten	Studierender Mikro- un chfrequenza der Nanoteceit moderne	en Konzepte und Strad Nanoelektronik. Da anwendungen sowie ochnologie. Die Studier Mikro- und Nanote der Klausur (max. She in Element 3. anstaltung bekannt ge	zu zählen die praktis renden sir chnologie 180 M	neuartige sche nd in der qualitativ	
5	Komp Nach von S niede Anwe Lage, zu ve Prüfu *Die Prüfu X Teilna Keine	er, T. Noll, ertenzen erfolgreich kalierungs erdimension endung gru die Konze rgleichen. ulprüfung: enleistung genauen P ungsforme Modulpr ahmevora	hem Abschluss of und Integration on ale Materialier undlegender Her pte im Hinblick mündliche Pen: Erfolgreiche Prüfungsmodaliter und –leistung üfung ussetzungen Verwendbarkeit dul im Masterstu	des Moduls kennen die nsproblemen moderne n und Halbleiter für Ho estellungsmethoden in auf die Leistungsfähigk Trüfung (max. 40 M Bearbeitung der Prakt äten werden spätesten en	Studierender Mikro- un chfrequenza der Nanoteceit moderne Minuten) och kumsversuc s zur 2. Vera	en Konzepte und Strad Nanoelektronik. Da anwendungen sowie ochnologie. Die Studier Mikro- und Nanote der Klausur (max. che in Element 3. anstaltung bekannt genommationstechnik", St	zu zählen die praktis renden sir chnologie 180 M egeben.	neuartige sche nd in der qualitativ	